

<i>Сапаев И. Б., Мирсагатов Ш. А., Сапаев Б., Кабулов Р. Р.</i> Механизм усиления фототока в инжекционных фотодиодах на основе фоточувствительной поликристаллической пленки CdS.....	129
<i>Хайдаров З., Юлдашев Х. Т., Хайдаров Б. З., Урмонов С.</i> Фотоэлектрические явления в сверхтонком (3–20 мкм) зазоре газового разряда с полупроводниковым электродом.....	136
<i>Юлдашев Х. Т., Хайдаров Б. З., Касымов Ш. С.</i> Исследование фотоэлектрических и фотографических характеристик полупроводниковой фотографической системы ионизационного типа.....	141
<i>Васильев В. В., Лучанинов А. А., Решетняк Е. Н., Стрельницкий В. Е., Толмачева Г. Н., Прибытков Г. А., Гурских А. В., Криницын М. Г.</i> Применение порошковых катодов для осаждения Ti-Si-N покрытий из фильтрованной вакуумно-дуговой плазмы.....	148
<i>Сычикова Я. А.</i> Модель формирования кластеров на поверхности полупроводниковых кристаллов группы A3B5.....	164
<i>Kapustianyk V., Turko B., Rudyk Y., Tsybul'skyi V., Rudyk V., Vaskiv A.</i> Room-temperature ultraviolet laser emission from zno hexagonal micropisms and nanowires.....	169
<i>Шкоропатенко А. В., Кудин А. М., Андрющенко Л. А., Волошина Л. И., Зосим Д. И., Волошин А. В.</i> Причины нестабильности спектрометрических характеристик кристаллов CsI:Tl с матированной поверхностью.....	175
<i>Малеев М. В., Зубарев Е. Н., Пуха В. Е., Дроздов А. Н., Вус А. С., Пеньков А. В.</i> Особенности взаимодействия ускоренных ионов C ₆₀ с поверхностью ИТО мишени.....	184
<i>Болезюк В. Б., Ковалюк З. Д., Фешак Т. М., Товарницький М. В.</i> Електричні властивості шаруватих монокристалів InSe та Bi ₂ Te ₃ , інтеркальованих C ₃ H ₈ O ₃	196
<i>Соболь О. В., Андреев А. А., Шепель С. В., Дмитрик В. В., Погребной Н. А., Ищенко Г. И., Князев С. А., Пинчук Н. В., Мейлехов А. А., Столбовой В. А., Сологуб М. О., Кривобок Н. А.</i> Использование структурного подхода при оценке эффективности газового и ионного азотирования сталей.....	202
<i>Гордиенко Ю. Е., Пятайкина М. И., Полищук А. В.</i> СВЧ высоколокальный сканирующий разогрев в технологии микро- и нанoeлектроники.....	209

Юлдашев Х. Т., Касымов Ш. С.	
Исследование характеристики преобразователя изображений в сверхтонкой газоразрядной ячейке с полупроводниковым электродом.....	218
Дядюра К. О., Юнак А. С., Погребняк А. Д., Охріменко В. О.	
Механізм зношення різальних інструментів на основі cBN при точінні зносостійких високохромистих чавунів.....	225
Ковалюк З. Д., Мінтянський І. В., Савицький П. І.	
Електрохімічна імпедансна спектроскопія джерел струму $\text{Li/Cu}_4\text{Bi}_6\text{S}_{11}$	235
Агеев Л. А., Белошенко К. С., Резникова В. М.	
Периодическая структура в фоточувствительной композитной пленке при возбуждении предельной TE_0 моды подложки.....	243
Клепиков В. Ф., Прохоренко Е. М., Литвиненко В. В., Брюховецкий В. В., Шатов В. В., Шульгин Н. А., Морозов А. И.	
Структурные особенности механизмов износа и разрушения материалов шаров барабанных мельниц.....	250
Миненков А. А., Крышталь А. П.	
Влияние характерного размера на твердофазную растворимость в плёночной системе Ag-Ge.....	259
Зыков А. В., Дудин С. В., Яковин С. Д.	
Стационарные режимы магнетронного разряда низкого давления.....	264
От редколлегии	
К 40-летию начала исследований в области плазменных технологий в микроэлектронике на физико-техническом факультете Харьковского университета.....	276
Від редколегії	
До 70-літнього ювілею.....	282
Правила оформлення рукописів.....	284
Правила оформления рукописей.....	285
Information for authors.....	286